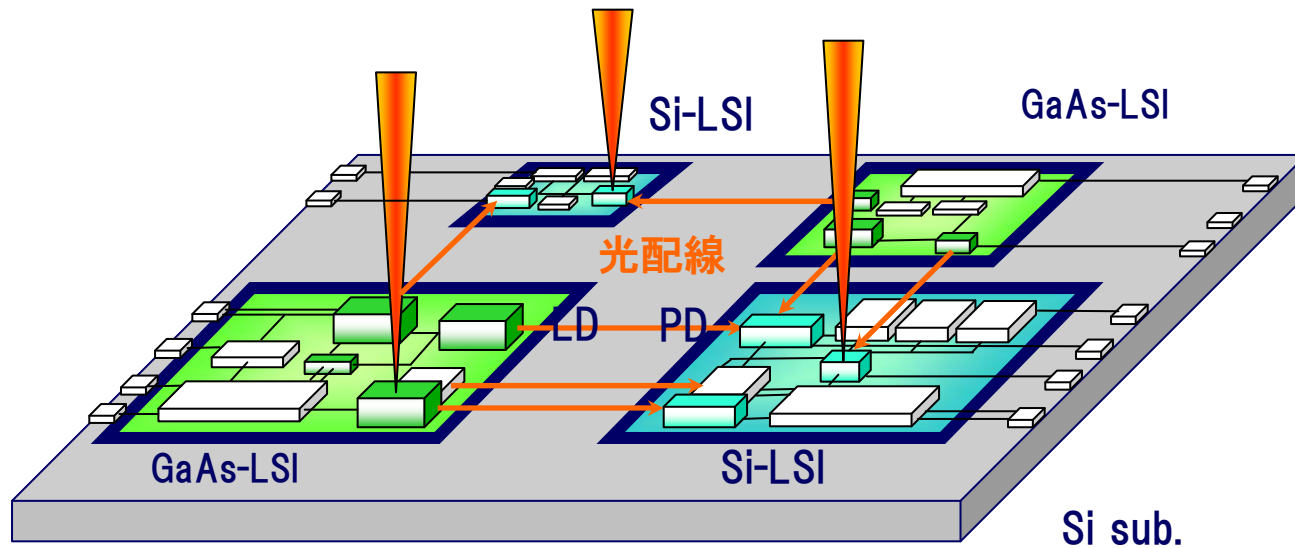


FIB及びMBE技術を用いた機能集積化デバイス形成に関する基礎的研究

電気電子工学系 准教授 朴 康司

目的

低加速FIBやMBE技術を用い、マスクレス成長などを行い化合物半導体デバイスを微細領域に形成する。



OEIC(光電子集積回路)への応用

H20年度計画

- ・ その場ドーピングをおこなうことで、GaAs、InGaAs 選択成長層のキャリア濃度の制御を行う。
- ・ GaN系薄膜のマスキレス選択成長およびドーピングを行う。また、MBEで成長したGaNをテンプレートにしたFIB成長も行う。

